

## ВЧ-25

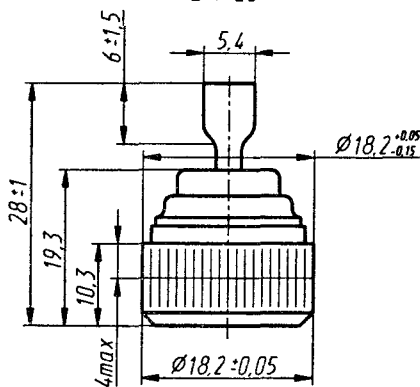
Диод кремниевый, диффузионный, быстродействующий. Предназначен для работы в цепях статических преобразователей электроэнергии постоянного и переменного токов на частотах до 10 кГц. Выпускается в металлокерамическом корпусе с жестким выводом. Охлаждение воздушное естественное или принудительное. Обозначение типономинала и полярность выводов приводятся на корпусе.

Масса диода не более 29 г.

### Электрические параметры

Импульсное прямое напряжение, не более .....	1,7 В
Повторяющийся импульсный обратный ток при $T_n = +200\text{ }^\circ\text{C}$ , $t_{и} = 10\text{ мс}$ , не более .....	20 мА
Время обратного восстановления при $T_n = +200\text{ }^\circ\text{C}$ , не более .....	6,3 мкс
Тепловое сопротивление переход—корпус, не более .....	0,6 $^\circ\text{C}/\text{Вт}$

ВЧ-25



### Предельные эксплуатационные данные

Средний прямой ток при $T_K = +150\text{ }^\circ\text{C}$ , $f = 50\text{ Гц}$ .....	25 А
Неповторяющийся импульсный прямой ток: при $T_n = +200\text{ }^\circ\text{C}$ , $t_n = 10\text{ мс}$ .....	375 А
при $T = +25\text{ }^\circ\text{C}$ .....	400 А
Повторяющееся импульсное обратное напря- жение при $T = +200\text{ }^\circ\text{C}$ , $t_n = 10\text{ мс}$ .....	600 В
Неповторяющееся импульсное обратное на- пряжение при $T = +200\text{ }^\circ\text{C}$ , $t_n = 10\text{ мс}$ .....	660 В
Постоянное обратное напряжение .....	400 В
Импульсное обратное напряжение .....	740 В
Температура перехода.....	-60...+200 °С
Температура корпуса.....	+150 °С

Монтаж диодов осуществляется запрессовкой в отверстие литого охладителя  $\varnothing 18\text{ мм}$  или штампованного охладителя  $\varnothing 18\text{ мм}$  с классом чистоты поверхности отверстия не менее 1,25, причем диод должен запрессовываться на глубину не менее 9 мм по высоте основания.

Запрессовку диода в отверстие необходимо производить через кондуктор, обеспечивающий непараллельность осей диода и отверстия не более  $1^\circ$ . Давление на основание диода при запрессовке должно осуществляться плоскостью с классом чистоты поверхности 1,25 и предельным отклонением от плоскости не более 10 мкм. Запрессовку необходимо производить плавно, без ударов, со скоростью 2...3 мм/с, с усилием 2500...9500 Н.

Не допускается приложение изгибающего усилия к выводу диода более 15 Н на расстоянии не более 2 мм от конца вывода.